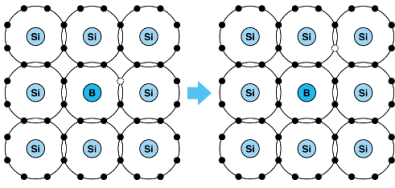
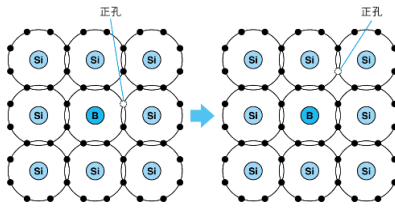
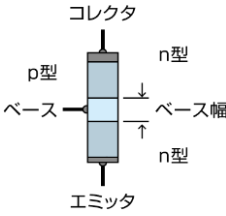
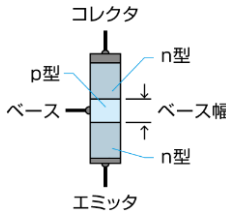
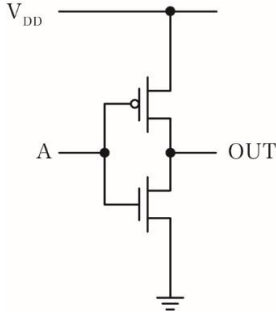
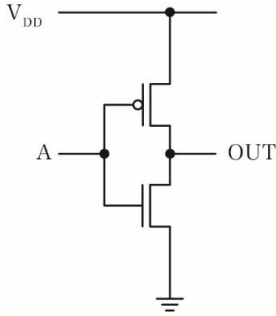
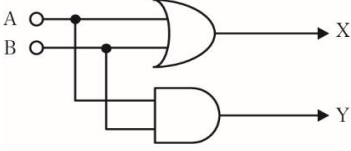
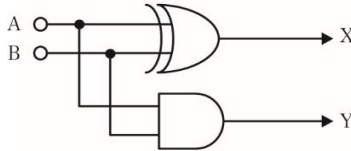
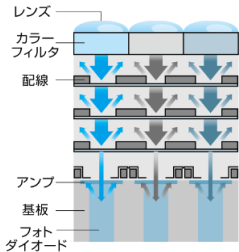
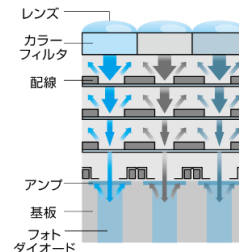
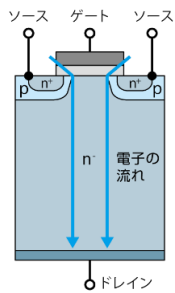
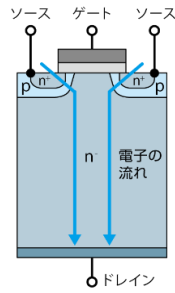


以下の通り表記に誤りがありました。ご迷惑をおかけしましたことを訂正してお詫び申し上げます。

該当刷ページ	該当箇所	【誤】	【正】
初版 p.23+A3:D18	図 1-1 (b) 鉱石検波器の動作	逆方向 電流が流れにくい(抵抗が <small>小</small>)	逆方向 電流が流れにくい(抵抗が <small>大</small>)
初版～2刷 p.24	下から4行目	前に述べたように、	その後、
初版 p.26	図 1-3 物体までの距離	$L(\text{km}) = C \times \frac{1}{2}$	$L(\text{km}) = C \times \frac{T}{2}$
初版 p.29	図 1-4 電気伝導率 σ	$\sim 10^{-10} 10^{-12} 10^{14} 10^{16} 10^{18}$	$\sim 10^{-10} 10^{-12} 10^{-14} 10^{-16} 10^{-18}$
初版 p.30	図 1-5	低 ← 湿度 → 高	低 ← 温度 → 高
初版 p.44	図 1-15		
初版～2刷 p.48	図 1-17	電流V	電圧V
初版～2刷 p.51	図 1-18	分子間による結合	分子間 力 による結合
初版 p.61	図 2-1 BOC	ベル 糸 電話会社	ベル 系 電話会社
初版 p.69	図 2-5 下から2番目の図	$0V < V_B < 1v$	$0V < V_B < 1V$
〃	図 2-5 1番下の図	$0V = V_B$	V_B
初版 p.73	〃		
初版 p.81	〃	Si 基盤	Si 基板
初版 p.88	図 2-17 (a)の図 (2か所)	基盤	基板
初版 p.100	図 2-24 (8か所)	基盤	基板
〃	図 2-24 1番上の右	(r)酸化膜の孔から～	(k)酸化膜の孔から～
〃	図 2-24 下から2番目の右	(m)表面の酸化膜に電極 芯 着用の～	(m)表面の酸化膜に電極 蒸 着用の～
初版～4刷 p.104	下から5行目	70mV ～ 360mV	70mV ～ 400mV

初版～4刷 p.110	図 3-3	11+11 (3×3) の計算	11 × 11 (3×3) の計算																				
初版～2刷 p.113	図 3-5	$0 + V_D$	$+ V_D$																				
初版 p.113	図 3-6	接地 V_{IN} 電源 (V_D)	電源 (V_D) V_{IN} 接地																				
初版～4刷 p.117	図 3-10																						
初版～4刷 p.135	図 3-24	【誤】 	<table border="1" data-bbox="1008 779 1321 929"> <thead> <tr> <th>A(入力)</th> <th>B(入力)</th> <th>X(出力)</th> <th>Y(出力)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A(入力)	B(入力)	X(出力)	Y(出力)	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
		A(入力)	B(入力)	X(出力)	Y(出力)																		
0	0	0	0																				
1	0	0	1																				
0	1	0	1																				
1	1	1	1																				
【正】 	<table border="1" data-bbox="1008 974 1321 1124"> <thead> <tr> <th>A(入力)</th> <th>B(入力)</th> <th>X(出力)</th> <th>Y(出力)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A(入力)	B(入力)	X(出力)	Y(出力)	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1		
A(入力)	B(入力)	X(出力)	Y(出力)																				
0	0	0	0																				
1	0	1	0																				
0	1	1	0																				
1	1	0	1																				
初版 p.163	図 4-14	V_{th0} (低い)	V_{th0}																				
初版～6刷 p.171	3行目	自由層は	記録層は																				
初版～2刷 p.177	図 5-1	⊖ 正孔 ⊕ 電子	⊖ 電子 ⊕ 正孔																				
〃	〃	(a) pn 接合面ダイオード	(a) pn 接合ダイオード																				
初版～5刷 p.179	図 5-2 (b)の図	内部電界	内蔵電界																				
初版～5刷 p.186	本文 最終行	バンドギャップが1.43eV で、	バンドギャップが1.42eV で、																				
初版～5刷 p.187	1行目	波長が980nm	波長が870nm																				
初版～2刷 p.197	図 5-17	(a) 半導体レーザーの構造	(b) 半導体レーザーの構造																				
初版 p.206	図 5-25																						

<p>初版 p.215</p>	<p>図 5-30</p>		
---------------------	---------------	---	---